



XDCR 名称	XDCR S/N	部分		浸泡前	浸泡后	差异（之前之后）	后果
14L5	21010221	抗电强度		0.152毫安	0.175毫安	-	通过
		泄漏试验		10.272 uA	10.885uA	-	通过
		探查 要素 测验	Sens. std 8.5兆赫	0.44分贝	1.1分贝	0.66分贝	通过
			Sens. std 频率为10.5MHz	0.54分贝	1.15分贝	0.61分贝	通过
			Sens. std 在6.0MHz	0.49分贝	0.55分贝	0.06分贝	通过
			TOF	2.88纳秒	5.63纳秒	2.75纳秒	通过
			死去的 要素	0	0	0	通过
		外观检查		无缺陷	无缺陷	-	通过

XDCR 名称	XDCR S/N	部分	浸泡前	浸泡后	差异（之前之后）	后果	
18L6	21080257	抗电强度		0.213毫安	0.248毫安	-	通过
		泄漏试验		13.114 uA	15.001 uA	-	通过
		探查 要素 测验	Sens. std 10.0兆赫	0.64分贝	0.64分贝	0分贝	通过
			Sens. std 120MHz	0.63分贝	0.66分贝	0.03分贝	通过
			Sens. std 在8.0MHz	0.59分贝	0.66分贝	0.07分贝	通过
			TOF	3.31纳秒	6.79纳秒	3.48纳秒	通过
			死去的 要素	1.	1.	0	通过
		外观检查		无缺陷	无缺陷	-	通过

XDCR 名称	XDCR S/N	部分	浸泡前	浸泡后	差异（之前之后）	后果	
4Z1c	20130044	抗电强度	0.363毫安	0.385毫安	-	通过	
		泄漏试验	24.854uA	26.332 uA	-	失败	
		探查 要素 测验	Sens. std 在1.2MHz	0.19伏/伏	0.22伏/伏	1.2773381597dB	通过
			Sens. std 3.0兆赫	0.15伏/伏	0.17伏/伏	1.087153246dB	通过
			TOF	9.7纳秒	9.5纳秒	0.2 ns	通过
			死去的 要素	20	20	0	通过
		外观检查	无缺陷	无缺陷	-	通过	
		最终决定	失败，4Z1c未能通过泄漏测试，但该样品已经有了很高的结果 试验前的泄漏试验。所以我们必须用状态良好的样品重新测试				

XDCR 名称	XDCR S/N	部分		浸泡前	浸泡后	差异（之前之后）	后果
8C3HD	21070497	抗电强度		0.253毫安	0.313毫安	-	通过
		泄漏试验		15.898uA	18.920 uA	-	通过
		探查 要素 测验	Sens. std 在6.0MHz	0.58分贝	0.59分贝	0.01分贝	通过
			Sens. std 3.5兆赫	0.41分贝	0.44分贝	0.03分贝	通过
			Sens. std 8.0兆赫	0.59分贝	0.6分贝	0.01分贝	通过
			TOF	4.55 ns	3.97纳秒	0.58纳秒	通过
			死去的 要素	0	0	0	通过
		外观检查		无缺陷	无缺陷	-	通过